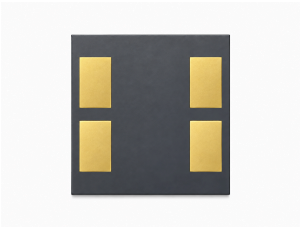
2 × 20 Ω GaAs薄膜抵抗ベアダイ

LCRES-N2-R20OHM — 2 × 20 Ω GaAs薄膜抵抗ベアダイ.

抵抗値: 20 / 20 Ω (標準値); リニア動作電流: 0.165 / 0.165 A (標準値); 最大許容電流: 0.33 A (最大値). ダイ平面寸法: 0.5 × 0.5 mm.



電気特性 TA = +25 °C

項目	記号	最小値	代表値	最大値	値	単位
抵抗素子数	-	-	-	-	2	-
端子数	-	-	-	-	4	-
抵抗値	-	-	20 / 20	-	-	Ω
抵抗値許容差	-	-	±5	-	-	%
リニア動作電流	-	-	0.165 / 0.165	-	-	A

絶対限界値

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
最大許容電流	-	-	-	0.33	A

環境仕様

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
保存温度	-	-65	-	150	°C
動作温度	-	-55	-	125	°C

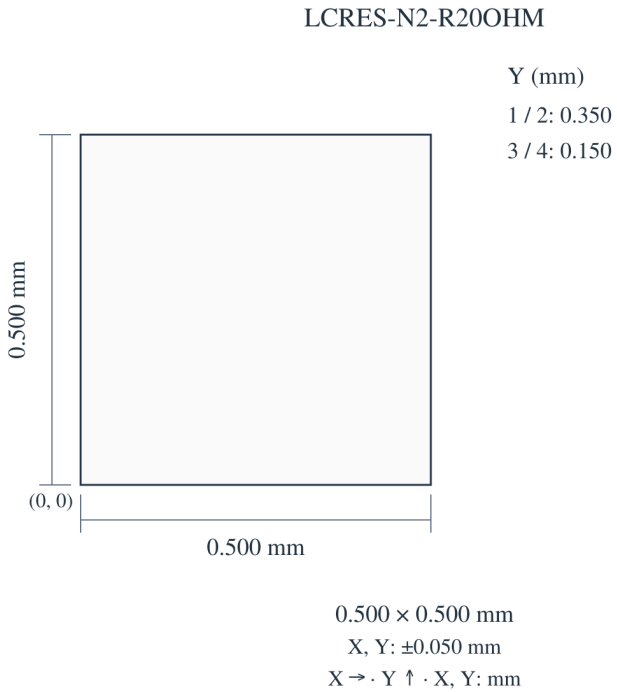
ボンディングパッド配置

ピン番号	記号	機能	備考
1, 2	IN1/OUT1	相反入力/出力	1
3, 4	IN2/OUT2	相反入力/出力	2
チップ裏面	GND	接地	RF / DC GND

ダイ寸法

項目	値	単位
ダイ平面寸法	0.5 × 0.5	mm

一部の寸法を mm で示した参考図です。製造およびワイヤボンディングには詳細図面を参照してください。



現在の発行記録 · 1.3 · 2026-11-12. 製品説明または編集内容を更新しました。 置き換え対象の改訂版 1.2.

ダイ実装とバイアスの印加順序

ダイ裏面を確実に接地してください。

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。